

2SD845

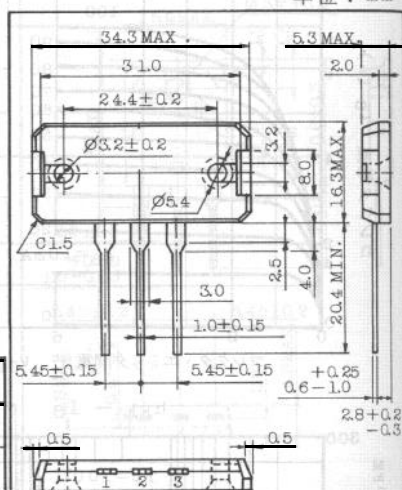
シリコンNPN三重拡散形トランジスタ

○ 電力増幅用

特 長

- ・ 高耐圧です。 : $V_{CE0}=150V$
- ・ トランジション周波数が高い。 : $f_T=20\text{ MHz}$ (標準)
- ・ 2SB755 とコンプリメンタリになります。
- ・ 80W ハイファイオーディオアンプ出力段に最適です。

単位: mm



最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	記 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	150	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	150	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	12	A
ベース電流	I_B	1.2	A
コレクタ損失 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	P_C	120	W
接 合 温 度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$

JEDEC

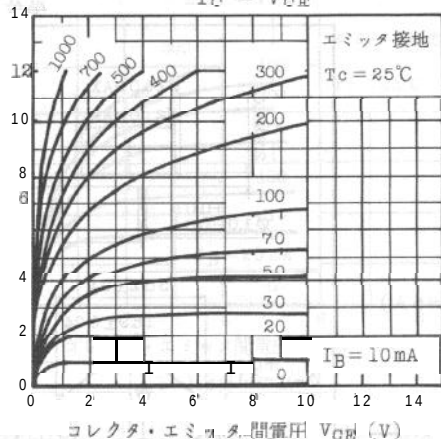
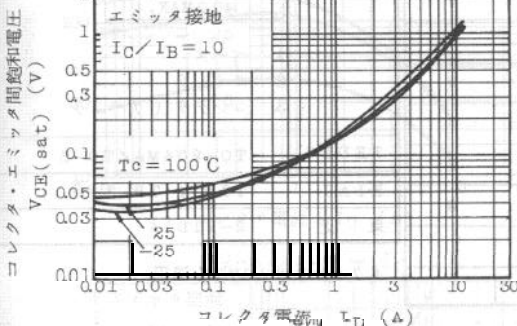
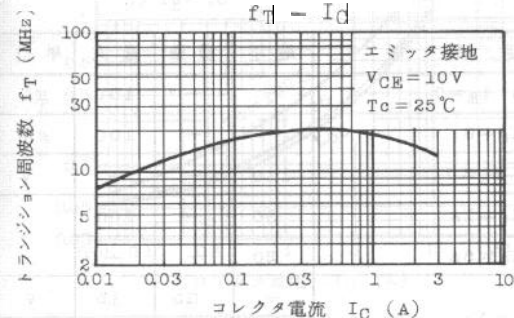
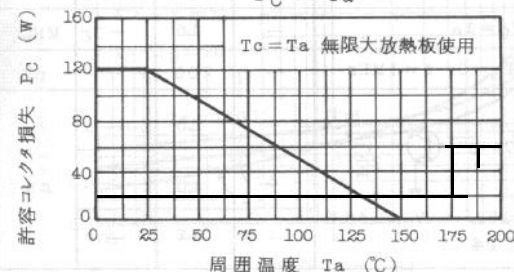
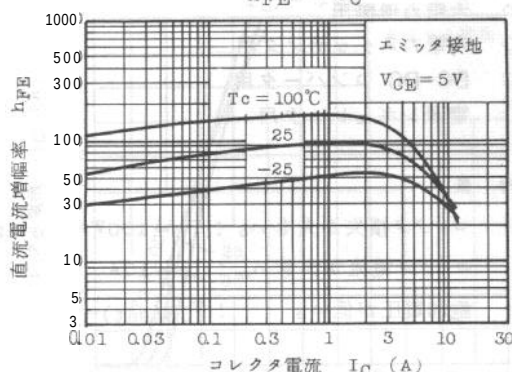
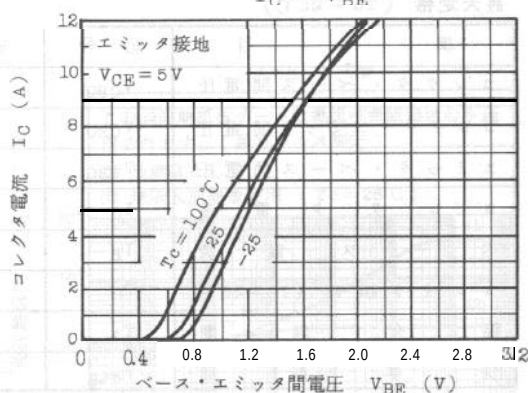
EIAJ

東 芝 2-34A1A

電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	記 号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=150V, I_E=0$	—	—	50	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5V, I_C=0$	—	—	50	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=0.1A, I_B=0$	150	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=10mA, I_C=0$	5	—	—	V
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE} (注)	$V_{CE}=5V, I_C=1A$	55	—	160	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=5V, I_B=0.5A$	—	—	2.0	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=5V, I_C=5A$	—	—	1.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=10V, I_C=1A$	—	20	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	200	—	pF

注: h_{FE} 分類 R: 55~110, 0: 80~160

$I_C - V_{CE}$ コレクタ電流 I_C (A) $V_{CE(sat)} - I_C$  $f_T - I_C$  $P_C - T_a$  $h_{FE} - I_C$  $I_C - V_{BE}$ 

安全動作領域

